

収録範囲	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子物理学および分子物理学</li> <li>回路理論および回路</li> <li>現象論の古典的分野</li> <li>通信</li> <li>部品, 電子装置および材料</li> <li>コンピュータ応用</li> <li>コンピュータのハードウェアおよびソフトウェア</li> <li>固体論 (構造, 機械的性質, 電子構造, 電子構造, 電気的性質, 磁氣的性質, 光学的性質)</li> <li>制御技術</li> <li>物理学周辺領域および科学技術関連領域</li> <li>電磁場</li> <li>工業数学, 材料科学</li> <li>流体力学, プラズマ, 放電</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ビジネスおよび経営への応用</li> <li>地球物理学, 天文学, 宇宙物理学</li> <li>情報技術</li> <li>計測ならびに応用</li> <li>磁気ならびに超伝導材料およびその装置</li> <li>核物理学</li> <li>数値解析および理論計算機科学</li> <li>オフィスオートメーションー通信, 電算機処理</li> <li>光学材料とその応用, 電子光学とオプトエレクトロニクス</li> <li>素粒子物理学</li> <li>動力システムとその応用</li> <li>システムおよび制御理論</li> </ul>
ファイル種類	文献データベース	
特徴	シソーラス	統制語 (/CT), 国際特許分類 (/IPC), 物理学的性質 (/PHP)
	アラート (自動 SDI 検索)	毎週 (デフォルト)
	CAS RN® (CAS 登録番号) <input type="checkbox"/>	ページイメージ <input type="checkbox"/> STN AnaVist <input type="checkbox"/>
	Keep & Share <input checked="" type="checkbox"/>	中間一致・ <input checked="" type="checkbox"/> STN Easy <input checked="" type="checkbox"/>
		後方一致検索
	練習用ファイル <input checked="" type="checkbox"/>	構造図 <input type="checkbox"/>
レコード内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>書誌情報, 索引語, 抄録, 物性情報, 元素記号, 国際特許分類 (適用可能な場合)</li> <li>1898-1968 年のアーカイブも収録。アーカイブは 873,700 を超える 1898-1968 年の Science Abstract Journal の情報を提供しています。これらのレコードは, 原報に記載されていた表, グラフ, 図を含み, さらに対応する最新の INSPEC の統制語と INSPEC 分類コードが収録されています。</li> </ul>	
レコード数	12,915,000 件以上のレコード, 3,700 件以上のイメージ (2011 年 7 月現在)	
収録年代	1898 年 -	
更新頻度	毎週更新	1 回の更新で約 6,000 件のレコードを追加
言語	英語	
データベース	The Institute of Engineering and Technology (IET)	
製作者	Michael Faraday House, Six Hills Way Stevenage, Herts SG1 2AY, United Kingdom Phone: (+44)1438-313311 Fax: (+44)1438-742840 E-mail: inspec@theiet.org 著作権所有者	

### ヨーロッパ STN カールスルーエ

FIZ Karlsruhe  
 P.O. Box 2465  
 76012 Karlsruhe  
 Germany  
 Phone: +49-7247-808-555  
 Fax: +49-7247-808-259  
 E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de  
 Internet: www.stn-international.de

### 日本 STN 東京 一般社団法人 化学情報協会

〒113-0021 東京都文京区本駒込6-25-4 中居ビル  
 Phone: 0120-003-462 (Help Desk)  
 : 0120-151-462 (上記以外)  
 Fax: 03-5978-4090  
 E-mail: support@jaici.or.jp (Help Desk)  
 customer@jaici.or.jp (上記以外)  
 Internet: www.jaici.or.jp

### 北アメリカ STN コロンバス

CAS  
 P.O. Box 3012  
 Columbus, Ohio 43210-0012 U.S.A  
 CAS Customer Care:  
 Phone: 800-753-4227 (North America)  
 614-447-3700 (worldwide)  
 Fax: 614-447-3751  
 E-mail: help@cas.org  
 Internet: www.cas.org

データベース 代理店	FIZ Karlsruhe P. O. Box 2465 D-76012 Karlsruhe Germany Phone: (+49) 7247-808-555 Fax: (+49) 7247-808-259 E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de	
収録源	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 雑誌論文</li> <li>• 技術レポート</li> <li>• 学会会議録</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 単行本</li> <li>• 学位論文</li> <li>• 特許 (1976 年以前)</li> </ul>
検索補助 資料	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspec List of Journals (データベース製作者またはオンラインより入手可能)</li> <li>• Inspec Classification (データベース製作者またはオンラインより入手可能)</li> <li>• Inspec Thesaurus (データベース製作者より入手可能)</li> <li>• Inspec レコードで使用されている IPC コード : <a href="http://www.stn-international.de/inspec_ipc.html">http://www.stn-international.de/inspec_ipc.html</a></li> <li>• STN 技術資料 <a href="http://www.jaici.or.jp/stn/stn_doc_01.html">http://www.jaici.or.jp/stn/stn_doc_01.html</a></li> <li>• オンラインヘルプ =&gt; HELP DIRECTORY ですべての利用可能なヘルプメッセージが表示されます</li> <li>• STNGUIDE ファイル</li> </ul>	
利用可能な クラスター	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AEROTECH</li> <li>• ALLBIB</li> <li>• AUTHORS</li> <li>• CHEMENG</li> <li>• CHEMISTRY</li> <li>• COMPUTER</li> <li>• CORPSOURCE</li> <li>• ELECTRICAL</li> <li>• ENGINEERING</li> <li>• ENVIRONMENT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FUELS</li> <li>• GEOSCIENCE</li> <li>• GOVREG</li> <li>• MATDATA</li> <li>• MATERIALS</li> <li>• MEETINGS</li> <li>• METALS</li> <li>• PETROLEUM</li> <li>• PHYSICS</li> <li>• SAFETY</li> </ul>

## SEARCH および DISPLAY フィールド

中間一致および後方一致検索可能なフィールドはアスタリスク (\*) で示してあります。

## 一般検索フィールド

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
基本索引* 標題 (/TI) 抄録 (/AB) 統制語 (/CT) 統制語, オリジナル (/CTO) 補遺語 (/ST) (以上からの切出し語)	なし または /BI	S MICROELECTRON? S QUANTUM HALL S LIQUID (A) CRYST? S AL203-NA20 S ?LASER?	TI, AB, CT, CTO, ST
抄録* レコード番号 出願日 <sup>1)</sup> 出願年 <sup>1)</sup> 天体 著者名 (編集者名, 発明者名) 原報入手先 <sup>2)</sup> INSPEC 分類コード <sup>3)</sup> (コードおよびテキスト) INSPEC 分類コード (旧形式) <sup>3), 4)</sup> (コードおよびテキスト) 化学物質索引 <sup>5), 6)</sup> 統制語 <sup>7)</sup> 統制語 (旧形式) <sup>4)</sup> 統制語 (単語) 所属機関 (特許出願人を含む) 発行国 (コードおよびテキスト) 資料番号 (抄録誌) 資料種類 (コードおよびテキスト) 入力日 <sup>1)</sup> 電子メールアドレス <sup>3)</sup> 元素数 (全元素数) <sup>1), 6)</sup> 元素記号 <sup>8), 9)</sup> (元素記号, 化学式, 化合物 (CP), 材料 (SY:2 金属以上), ドーパント, 陰イオン (IN), 陽イオン (IP), 同位体 (IS), 核反応 (ターゲット T, 反応 R, 最終核種 F)を含む) フィールドの存在 ファイルセグメント 図面イメージ (サイズ) <sup>4)</sup> 図面イメージ (タイプ) <sup>4)</sup> 国際特許分類 <sup>7)</sup> 出版物の号数 <sup>1)</sup>	/AB /AN /AD /AY /AO /AU /AV /CC /CCO /CHI または /MAI /CT /CTO /CW /CS /CY /DN /DT または /TC /ED /EML /ELC /ET /FA /FS /GIS /GIT /IPC /IS	S NEUTRON ?RADIATION?/AB S 2004:7817461/AN S AD=APR 1969 S AY=1970 S WESTERBORK-53 91/AO S "A 0535+26"/AO S SMITH S E/AU S NASA CENTER/AV S A9110Q/CC S A4/CC S A41/CC S OPTICAL DEVICE?/CC S MATHEMATICAL PHYSICS/CCO S 621.791/CCO S BA DOP/CHI S CU SS/CHI S (IN SS(S)GA SS(S)AS SS)/CHI S (LA(S)CU(S)O)/CHI(L)ELC=3 S MAGNETIC LEVITATION/CT S MANGANESE BISMUTHIDE/CTO S MAGNETIC/CW S (NAT(W)BUR?(2W)WASH?)/CS S GAIN ELECTRON?/CS S NL/CY S AUSTRALIA/CY S C1983-014353/DN S BOOK/DT S GENERAL REVIEW/TC S L1 AND ED>20040100 S HEIDEL IBM/EML S CA/CHI(L)ELC>2 S LA2CUO4/ET S CL*XE/ET S LA CP/ET S CU SY 3/ET S SI:H/ET S CA IP 2/ET S PB IS/ET S 6LI R/ET S BANDWIDTH/FA S B/FS AND SAFETY S 10057/GIS S GIF/GIT S B82B0001-00/IPC S IS=8	AB AN AI AI AO AU AV CC CCO CHI CT CTO CT AU, CS CY DN DT TC ED AU, EML 表示されない ET PHP FS GIS GIT IPC SO, IS

(続く)

## 一般検索フィールド

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
国際標準 (資料) 番号 (CODEN, ISBN, および ISSN を含む)	/ISN	S 1220-3033/ISN S 1 88044 651 0/ISN S AABNAC/ISN	SO, ISN
雑誌名 (完全名と略名)	/JT	S CREATIVE COMPUT?/JT	JT, JTF, JTA SO, LA
言語 (コードおよびテキスト)	/LA	S GERMAN/LA S RU/LA	LA
会議開催日 <sup>1)</sup>	/MD	S 15 DEC 1999/MD	MD, SO
会議開催場所 <sup>3)</sup>	/ML	S NANTES/ML	ML, SO
会議名	/MT	S SYSTEM STRUCTURE/MT	MT, SO
会議開催年 <sup>1)</sup>	/MY	S 2004-2005/MY	MY, SO
契約番号	/NC	S 016-77-1 RPU B/NC	NC
注記 <sup>3), 4)</sup>	/NTE	S ALSO PUBLISHED/NTE	NTE
レポート番号 (番号および接頭辞)	/NR	S GEPP-8/NR S GEPP/NR	NR
出版社 <sup>3)</sup>	/PB	S MCGRAW LONDON/PB	PB, SO
特許出願人 <sup>3), 9)</sup>	/PA	S BATTELLE CORP/PA	PA
特許発行国 (コードおよびテキスト) <sup>9)</sup>	/PC	S GB/PC	PC
特許番号 (オリジナル形式) <sup>9)</sup>	/PNO	S GB1 122 151/PNO	PNO
周期律グループ	/PG	S A8/PG	表示されない
物理的性質 <sup>7), 10)</sup>	/PHP	S EXCIMER LASERS/CT AND 2. 48E-07-3. 52E-07/W	PHP
優先権主張国 (コードおよびテキスト) <sup>9)</sup>	/PRC	S CA/PRC	PRAO
優先権主張日 <sup>1), 9)</sup>	/PRD	S DEC 1960/PRD	PRAO
優先権出願番号 (オリジナル形式) <sup>9)</sup>	/PRNO	S AT-6652/PRNO	PRAO
優先権主張年 <sup>1), 9)</sup>	/PRY	S PRY>1965	PRAO
発行日 <sup>1), 9)</sup>	/PD	S JAN 2004-MAR 2004/PD	PNO, SO
発行年 <sup>1)</sup>	/PY	S 2004-2005/PY	PNO, SO
引用文献数 <sup>1)</sup>	/REC	S L1 AND REC<10	REC, SO
収録源 (雑誌名とその他の標題, ISBN, ISSN, CODEN, SICI, URL, 出版社, 会議情報, 契約番号, レポート番号を含む)	/SO	S EARTH PLANET/SO S (CREATIVE COMP? (L) USA)/SO S 0031-9201/SO S WWW. COMPUTER. ORG/SO	SO
補遺語 <sup>11)</sup>	/ST	S AL203-NA20/ST S MEASUR? DEVICE#/ST	ST
標題*	/TI	S GRAVITY PARAMETERS/TI	TI
収録源の URL <sup>2), 3)</sup>	/URL	S JHEP ARCHIVE/URL	URL, SO
更新日 <sup>1)</sup>	/UP	S UP=FEB 2009	UP
号数 <sup>1)</sup>	/VL	S VL=5	SO
標題の単語数 <sup>1)</sup>	/WC. T	S L1 AND WC. T>10	WC. T

1) 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。

2) 1969 年以降のデータでのみ利用できます。

3) このフィールドでは (S) 演算子はスペースで代用できます。

4) 1898-1969 年のデータでのみ利用できます。

5) 1987 年以降のレコードに対してはロールが利用できます。ロールを含め、一つの化学式に属するすべての単一元素は、個別または (S) 演算子で組み合わせて検索できます。使用できるロールは、ロール一覧表に記載されています。

6) 元素数 (/ELC) は、/CHI と (L) 演算子でリンクできます。

7) このフィールドではシソーラスが利用できます。

8) 元素間にアスタリスク (\*) をつけて Hill 方式の順序で記述します。

9) 1976 年以前のデータでのみ利用できます。

10) 物理的性質については、物性フィールドを参照してください。1987 年以降のレコードで利用できます。

11) 合金はフレーズとしてのみ索引されます

## 物性フィールド

フィールド	デフォルト 単位	SEARCH コード	SEARCH 例 <sup>2)</sup>	DISPLAY コード
年 <sup>1)</sup>	yr	/AGE	S 2E3/AGE	PHP
高度 <sup>1)</sup>	M	/ALT	S ALT>2. 1	PHP
帯域幅 <sup>1)</sup>	Hz	/BAW	S 7. 4E-1/BAW	PHP
ビットレート <sup>1)</sup>	bit/s	/BIR	S 0. 2-0. 4/BIR	PHP
バイトレート <sup>1)</sup>	Byte/s	/BYR	S BYR<200	PHP
静電容量 <sup>1)</sup>	F	/CAP	S . 102E+2/CAP	PHP
コンピュータの命令実行回数 <sup>1)</sup>	IPS	/COE	S 66E5/COE	PHP
コンダクタンス <sup>1)</sup>	S	/CON	S 1. 5/CON	PHP
コンピュータの演算速度 <sup>1)</sup>	FLOPS	/COS	S 151E3-200E3/COS	PHP
電流 <sup>1)</sup>	A	/CUR	S 4. 11-4. 17/CUR	PHP
深さ <sup>1)</sup>	m	/DEP	S 5. 33E-3/DEP	PHP
距離 <sup>1)</sup>	m	/DIS	S 5. 99<DIS<6. 99	PHP
伝導率 <sup>1)</sup>	S/m	/ECND	S ECND<=7. 084	PHP
電子ボルトエネルギー <sup>1)</sup>	eV	/EEV	S 8005E-4/EEV	PHP
効率 <sup>1)</sup>	percent	/EFF	S 20-30/EFF	PHP
エネルギー <sup>1)</sup>	J	/ENE	S 3. 2/ENE	PHP
電気抵抗率 <sup>1)</sup>	ohm*m	/EREST	S 2. 0E-2-1. 0E5/EREST	PHP
		または/REE		
周波数 <sup>1)</sup>	Hz	/FRE	S 2028E2/FRE	PHP
銀河距離 <sup>1)</sup>	pc	/GAD	S 3. 26/GAD	PHP
利得 <sup>1)</sup>	dB	/GAI	S 1. 0E1-1. 5E1/GAI	PHP
地心距離 <sup>1)</sup>	m	/GED	S GED<1. 3E9	PHP
日心距離 <sup>1)</sup>	AU	/HED	S 12. 53666/HED	PHP
損失 <sup>1)</sup>	dB	/LOS	S 1E-2/LOS	PHP
質量 <sup>1)</sup>	kg	/M	S 7/M	PHP
メモリサイズ <sup>1)</sup>	Byte	/MES	S 12-20/MES	PHP
磁束密度 <sup>1)</sup>	T	/MFD	S 0. 0E1/MFD	PHP
		または/B		
雑音指数 <sup>1)</sup>	dB	/NOF	S 4. 5/NOF	PHP
画像サイズ <sup>1)</sup>	pixel	/PIS	S 6E3/PIS	PHP
皮相電力 <sup>1)</sup>	VA	/POA	S 7E7/POA	PHP
無効電力 <sup>1)</sup>	VAr	/POR	S -7E7/POR	PHP
電力 <sup>1)</sup>	W	/POW	S 17/POW	PHP
圧力 <sup>1)</sup>	Pa	/PRES	S 2. 5E8/PRES	PHP
		または/P		
プリント速度 <sup>1)</sup>	cps	/PRSP	S 30-35/PRSP	PHP
		または/PRS		
放射能 <sup>1)</sup>	Bq	/RAD	S 5. 6E+09/RAD	PHP
放射線吸収量 <sup>1)</sup>	Gy	/RADA	S 1. 0E0-1. 0E2/RADA	PHP
線量当量 <sup>1)</sup>	Sv	/RADE	S 1/RADE	PHP
放射線被爆量 <sup>1)</sup>	C/kg	/RAE	S 1. 3E-02/RAE	PHP
電気抵抗 <sup>1)</sup>	ohm	/RES	S 2. 0E5/RES	PHP
記憶容量 <sup>1)</sup>	bit	/SCA	S 4-5/SCA	PHP
サイズ <sup>1)</sup>	m	/SIZ	S 5/SIZ	PHP
恒星質量 <sup>1)</sup>	Msol	/STM	S . 6/STM	PHP
温度 <sup>1)</sup>	K	/TEMP	S 2. 4-3. 2/TEMP	PHP
		または/T		
時間 <sup>1)</sup>	s	/TIM	S 2. 7E+3/TIM	PHP
速度 <sup>1)</sup>	m/s	/VEL	S 4. 01-4. 13/VEL	PHP
		または/V		
電圧 <sup>1)</sup>	V	/VOLT	S 3. 3E-1/VOLT	PHP
ワード長 <sup>1)</sup>	bit	/WOL	S 2E2-3E3/WOL	PHP
波長 <sup>1)</sup>	m	/WVL	S 6. 0E1-1. 3E2/WVL	PHP
		または/W		

1) 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。

2) 数値の検索に対しては、例えば 1. 8E+4 あるいは 1. 8E4 (18000に対して) および 9. 2E-1 (0. 92に対して) のように、指数形式が推奨されます。

## 統制語 (/CT) シソーラス

すべての関係コードは、特に指示がない限り SEARCH および EXPAND コマンドで使用できます。

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語 (BT, SELF, KT, DA, USE, UF, NT, RT, PT, CC)	E ALUMINIUM COMPOUNDS+ALL/CT
AUTO <sup>1)</sup>	自動関係 (SELF, USE, UF)	S POWDER SPRAYING+AUTO/CT
BT	上位語 (BT, SELF)	E TERBIUM ALLOYS+BT/CT
HIE	階層関係語 (上位語と下位語) (BT, SELF, NT)	E SHOCK WAVES+HIE/CT
KT	キーワード (入力語を含むシソーラス用語) (SELF, KT)	E POWDER+KT/CT
NOTE	注記 (SELF, DA, CC)	E ELECTRIC MACHINES+NOTE/CT
NT	下位語 (SELF, NT)	S ACOUSTIC TRANSDUCERS+NT/CT
PFT	優先語および非優先語 (SELF, DA, USE, UF)	E MACHINES, ELECTRIC+PFT/CT
PT	以前の統制語 (SELF, DA, PT)	E DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS+PT/CT
RT	関連語 (SELF, RT, PT, CC)	E TRANSIENT ANALYSERS+RT/CT
STD	標準的な関係語 (BT, SELF, NT, RT, PT)	E TRANSFER FUNCTIONS+STD/CT
UF	非優先語 (SELF, UF)	E TRANSDUCERS+UF/CT
USE	優先語 (SELF, USE)	E ACOUSTIC DETECTORS+USE/CT

1) 自動関係のデフォルトは OFF になっています。SET RELATION ON に設定すると、関係コードをつけずに EXPAND した結果は関係コードを AUTO としたときと同じになります。この関係コードは EXPAND コマンドでのみ使用できます。

## 物性 (/PHP) シソーラス

関係コード	内 容	入 力 例
ALL	すべての関係語 (SELF, FQS, INSPEC, CGS, ENG, FPS, MKS, SI, STN, OTHER, UTP, USE, UF, DEF)	E CURRENT+ALL/PHP
NOTE <sup>1)</sup>	注記 (SELF, INSPEC, CGS, ENG, FPS, MKS, SI, STN, OTHER, DEF)	E ALTITUDE+NOTE/PHP
PFT	優先語および非優先語 (SELF, UTP, USE, UF)	E APPARENT POWER+PFT/PHP
UF	非優先語 (SELF, UF)	E SIZE+UF/PHP
UNIT <sup>1)</sup>	単位 (SELF, FQS, INSPEC, CGS, ENG, FPS, MKS, SI, STN)	E STORAGE CAPACITY+UNIT/PHP
USE	優先語 (SELF, USE)	E RADIUS+USE/PHP

1) この関係コードは EXPAND コマンドでのみ使用できます。

## /CT, /PHP シソーラスのフィールド・ディスクリプタ

コード	意 味
SELF	入力ターム
FQS	検索フィールド
INSPEC	INSPEC により付与された単位
CGS	CGS 単位記号
ENG	工学単位記号
FPS	FPS 単位記号
MKS	MKS 単位記号
SI	SI 単位記号
STN	STN 単位記号
OTHER	すでに付与されているもの以外で冊子体に記述されている単位
DA	ディスクリプタ登録日
DEF	定義
UTP	単位を使用する物性
USE	優先語
UF	非優先語

## ローラー一覧表

コード	内 容
ADS	吸着体あるいは物質に吸(収)着される吸着体
BIN	2 成分系
DOP	ドーパント
EL	元素
INT	界面系
SS	3 成分以上の多成分系
SUR	表面あるいは基板

## 国際特許分類 (/IPC) シソーラス

WIPO の国際特許分類 (IPC) の第 8 版の分類や、主見出しおよび副見出しのキャッチワードが利用できます。第 1 版～第 7 版のシソーラスも別に用意されています。旧版 (第 1 版～第 7 版) のシソーラスを EXPAND または SEARCH する場合は、フィールドコードに続いて各版の番号を入力します。例えば第 2 版では /IPC2 のように入力します。キャッチワードのシソーラスは IPC の第 5 版～第 8 版でのみ利用できます。

関係コード	内容	入力例
ADVANCED (ADV)	入力した IPC に対応するアドバンスレベルの IPC (SELF, ADVANCED)	E A61K0006-02+ADVANCED/IPC
ALL	すべての関係語 (BT, SELF, NT, RT)	E C01C0003-00ALL/IPC
BRO (MAN)	すべてのクラス	E C01C+BRO/IPC
BT	上位語 (SELF, BT)	E C01F0001-00+BT/IPC
CORE (COR)	入力した IPC に対応するコアレベルの IPC (SELF, CORE)	E G08C0019-22+CORE/IPC
ED	入力語の完全な標題と IPC の版	E C01F0001-00+ED/IPC
HIE	階層語 (すべての上位語と下位語) (BT, SELF, NT)	E C01F0003-00+HIE/IPC
INDEX	入力語の完全な標題	E C01F0001-00+INDEX/IPC
KT	キーワードターム (キャッチワード) (SELF, KT)	E CYANOGEN+KT/IPC
NEXT	次の分類	E C01C0001-00+NEXT5/IPC
NT	下位語 (SELF, NT)	E C01C+NT/IPC
PREV	前の分類	E C01C0001-12+PREV10/IPC
RT (SIB)	関連語 (BT, SELF, RT)	E C01C0003-20+RT/IPC
TI	入力語とその上位語の完全な標題 (BT, SELF)	E C01F0001-00+TI/IPC

## DISPLAY および PRINT 形式

回答のディスプレイとオフラインプリントには、下記の表示形式を自由に組み合わせることができます。複数のコードは、“D L1 1-5 TI AU”のようにスペースやカンマで区切ってください。フィールドは指定された順序で表示されます。

ほとんどの検索フィールドでヒットタームハイライト機能が使えます。HIT, KWIC, OCC 形式を使うためには、検索時にヒットタームハイライト機能が ON になっている必要があります。

形 式	英 語 名	内 容	入 力 例
AB <sup>1)</sup>	Abstract	抄録	D TI AB
AI	Application Information	出願情報	D AI
AN <sup>1)</sup>	Accession Number	レコード番号	D 1-5 AN
AO <sup>1)</sup>	Astronomical Object	天体	D AO
AU	Author (Patent Inventor)	著者名 (発明者名)	D AU TI
AV	Availability	原報入手先	D AV
CC	Classification Code	分類コード	D CC
CCO	Classification Code, Original	分類コード (オリジナル形式)	D CTO
CHI	Chemical Indexing	化学物質索引	D CHI
CS	Corporate Source (includes AU)	所属機関 (AU を含む)	D CS
CT	Controlled Term	統制語	D CT
CTO	Controlled Term, Original	統制語 (オリジナル形式)	D CTO
CY <sup>1)</sup>	Country of Publication	発行国	D CY 1, 3
DN <sup>1)</sup>	Document Number	資料番号	D DN
DT (TC) <sup>1)</sup>	Document Type (includes TC)	資料種類 (TC を含む)	D DT
ED <sup>1), 2)</sup>	Entry Date	入力日	D ED
EML	E-mail address	電子メールアドレス	D EML
ET <sup>1)</sup>	Element Terms	元素記号	D ET
FS <sup>2)</sup>	File Segment	ファイルセグメント	D FS
GI	Graphic Image	図面イメージ	D GI
GIS	Graphic Image, Size	図面イメージ (サイズ)	D GIS
GIT <sup>2)</sup>	Graphic Image, Type	図面イメージ (タイプ)	D GIT
IPC	International Patent Classification	国際特許分類	D IPC
ISN <sup>2)</sup>	International Standard (Document) Number	国際標準 (資料) 番号	D ISN
JT <sup>2)</sup>	Journal Title	雑誌名	D JT
JTA <sup>2)</sup>	Journal Title, Abbreviated	雑誌名 (略名)	D JTA
JTF <sup>2)</sup>	Journal Title, Full	雑誌名 (完全名)	D JTF
LA <sup>1)</sup>	Language	言語	D LA TI
MD <sup>2)</sup>	Meeting Date	会議開催日	D MD
ML <sup>2)</sup>	Meeting Location	会議開催場所	D ML
MT <sup>2)</sup>	Meeting Title	会議名	D MT
MY <sup>2)</sup>	Meeting Year	会議開催年	D MY
NC <sup>1)</sup>	Number of Contract	契約番号	D NC
NR	Number of Report	レポート番号	D NR
NTE	Note	注記	D NTE
PA	Patent Assignee	特許出願人	D PA
PB <sup>2)</sup>	Publisher	出版社	D PB
PD <sup>2)</sup>	Publication Date	発行日	D PD
PHP <sup>1)</sup>	Physical Properties	物理的性質	D PHP
PNO	Patent Number, Original	特許番号 (オリジナル形式)	D PNO
PRAO	Priority Information, Original	優先権情報 (オリジナル形式)	D PRAO
PY <sup>2)</sup>	Publication Year	発行年	D PY
REC (RE. CNT)	Reference Count	引用文献数	D REC
SO	Source (includes NC and NR)	収録原 (NC と NR を含む)	D SO
ST	Supplementary Term	補遺語	D CT ST 5 15
TI <sup>1)</sup>	Title	標題	D TI 1-10
UP <sup>1), 2)</sup>	Update Date	更新日	D UP
URL	Uniform Resource Locator	収録源の URL	D URL
WC. T <sup>1), 2)</sup>	Word Count, Title	単語数 (標題)	D WC. T

(続く)



## DISPLAY および PRINT 形式

形式	英語名	内容
ABS <sup>1)</sup>	AN, DN, AB	D ABS
ALL	AN, DN, TI, AU, CS, NC, NR, SO, AV, DT, TC, CY, LA, GIS, AB, CC, CCO, CT, CTO, ST, IPC, AO, CHI, PHP, ET 特許: AN, DN, TI, AU, PA, PNO, AI, PRAO, DT, TC, CY, LA, AB, CC, CCO, CT, CTO, ST, ET, IPC	D 1-3 ALL
BIB	AN, DN, TI, AU, CS, NC, NR, SO, AV, DT, TC, CY, LA, GIS 特許: AN, DN, TI, AU, PA, PNO, AI, PRAO, DT, TC, CY, LA (デフォルトは BIB)	D 8 BIB
ALLG	イメージ付き ALL 形式	
BIBG	イメージ付き BIB 形式	
DALL	デリミタ型 ALL 形式	D DALL
IALL	フィールド名付きインデント型 ALL 形式	D IALL
IBIB	フィールド名付きインデント型 BIB 形式	D IBIB
IND <sup>1)</sup>	AN, DN, CC, CCO, CT, CTO, ST, IPC, AO, CHI, PHP, ET	D IND
SCAN <sup>1,3)</sup>	TI, CT (回答番号なしのランダム表示)	D SCAN
TRIAL (TRI, SAMPLE, SAM, FREE) <sup>1)</sup>	TI, CC, CCO, CT, CTO, ST, IPC, AO, CHI, PHP, ET	D TRI
HIT	ヒットタームを含むフィールド	D HIT
KWIC	ヒットタームの前後 20 語を表示 (KeyWord-In-Context)	D KWIC
OCC	ヒットタームの出現頻度をフィールドごとに表示	D OCC

1) オンライン・ディスプレイ料金は無料です。

2) カスタム形式でのみ表示できます。

3) SCAN は DISPLAY コマンドに続けて入力します。例: D SCAN あるいは DISPLAY SCAN

## SELECT, ANALYZE および SORT フィールド

SELECT コマンドは、回答セットの指定したフィールドから抽出した語句に E 番号を付与します。

ANALYZE コマンドは、回答セットの指定したフィールドから抽出した語句に L 番号を付与します。

SORT コマンドは、検索結果を指定したフィールドのアルファベット順または数値順に並べ替えます。

(該当項目は Y, 該当しないものは N で表示されています)

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT <sup>1)</sup>	SORT
抄録	AB	Y	N
レコード番号	AN	Y	N
特許出願日	AD	Y	Y
天体	AO	Y	Y
著者名 (発明者名)	AU	Y	Y
化学物質索引	CHI	Y	N
引用文献	CIT (RE)	Y <sup>2), 3)</sup>	N
分類コード	CC	Y	Y
分類コード (オリジナル形式)	CCO	Y	Y
CODEN	CODEN	N	Y
統制語	CT	Y	N
統制語 (オリジナル形式)	CTO	Y	N
所属機関	CS	Y	Y
発行国	CY	Y	Y
資料番号	DN	Y	N
資料種類	DT (TC)	Y	Y
入力日	ED	Y	Y
電子メールアドレス	EML	Y	Y
元素記号	ET	Y	N
図面イメージ (サイズ)	GIS	Y	N
図面イメージ (タイプ)	GIT	Y	N

(続く)

## SELECT, ANALYZE および SORT フィールド

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT <sup>1)</sup>	SORT
国際特許分類	IPC	Y	Y
国際標準 (資料) 番号	ISN	Y	N
国際標準図書番号	ISBN	N	Y
国際標準逐次刊行物番号	ISSN	N	Y
雑誌名	JT	Y <sup>2)</sup>	Y
雑誌名 (略名)	JTA	Y <sup>4)</sup>	Y
雑誌名 (完全名)	JTF	Y <sup>4)</sup>	Y
言語	LA	Y	Y
会議開催日	MD	Y	Y
会議開催場所	ML	Y	Y
会議名	MT	Y	Y
会議開催年	MY	Y	Y
契約番号	NC	Y	Y
注記	NTE	Y	Y
レポート番号	NR	Y	Y
ヒットタームの出現頻度	OCC	N	Y
特許出願人	PA	Y	Y
出版社	PB	Y	Y
特許発行国	PC	Y	Y
特許番号 (オリジナル形式)	PNO	Y	Y
優先権主張番号 (オリジナル形式)	PRAO	Y	Y
優先権主張国	PRC	Y	Y
優先権主張日	PRD	Y	Y
優先権主張年	PRY	Y	Y
優先権出願番号 (オリジナル形式)	PRAO	Y	Y
発行日	PD	Y	Y
発行年	PY	Y <sup>2)</sup>	Y
引用文献数	REC (RE. CNT)	Y <sup>5)</sup>	Y
収録源	SO	Y <sup>6)</sup>	Y
補遺語	ST	Y	Y
資料種類	TC	Y <sup>7)</sup>	Y
標題	TI	Y (デフォルト)	Y
更新日	UP	Y	Y
収録源の URL	URL	Y	Y
標題の単語数	WC. T	Y	Y

1) ヒットタームだけを抽出させるには、HIT を使います。例: SEL HIT TI

2) SELECT HIT と ANALYZE HIT はこのフィールドでは使えません。

3) 第一著者名、発行年、巻、先頭ページが SELECT または ANALYZE され、SELECT されたタームに、前方一致記号と /RE が付与されます。

4) SELECT で抽出されたタームに /JT が付与されます。

5) SELECT で抽出されたタームに /RE. CNT が付与されます。

6) CODEN, ISSN, ISBNが SELECT または ANALYZE され、/SO が付与されます。

7) SELECT で抽出されたタームに /DT が付与されます。

## サンプルレコード

ALL 形式での表示 (雑誌論文レコード)

AN 2010:11289782 INSPEC [Full-text](#)  
 TI Performance improvement of AlGaN/GaN HEMTs using two-step silicon nitride passivation  
 AU Heng-Kuang Lin; Hsiang-Lin Yu; Huang, F.-H. (Dept. of Electr. Eng., Nat. Central Univ., Jhongli, Taiwan)  
 Email: hklin@ee.ncu.edu.tw  
 SO Microwave and Optical Technology Letters (July 2010), vol.52, no.7, p. 1614-19, 19 refs.  
 CODEN: MOTLE0, ISSN: 0895-2477  
 Published by: John Wiley & Sons Inc., USA  
 DT Journal  
 TC Practical; Experimental  
 CY United States  
 LA English  
 AB We report fabrication of AlGaN/GaN high electron mobility transistor (HEMT) with improved DC, high frequency and microwave power performances by employing a two-step passivation approach. A pretreated AlGaN surface is provided by dry etching n+-GaN cap layer and RTA annealing ohmic contacts right before Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> passivant is deposited. No additional process step is associated with the surface preparation for the passivation process. Pulsed I-V characteristics show that the proposed passivation process successfully eliminates trapping effect at Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> and AlGaN interface and is considered to be the important factor for the performance enhancement. .COPYRGT. 2010 Wiley Periodicals, Inc.  
 CC B2560S Other field effect devices; B2550E Surface treatment (semiconductor technology); B2550A Annealing processes in semiconductor technology  
 C21D0001/00 General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching, tempering  
 H01L0021/02 Manufacture or treatment of semiconductor devices or of parts thereof  
 H01L0029/00 Semiconductor devices specially adapted for rectifying, amplifying, oscillating or switching and having at least one potential-jump barrier or surface barrier; Capacitors or resistors with at least one potential-jump barrier or surface barrier, e.g. pn-junction depletion layer or carrier concentration layer; Details of semiconductor bodies or of electrodes thereof  
 CT aluminium compounds; etching; gallium compounds; high electron mobility transistors; III-V semiconductors; ohmic contacts; passivation; rapid thermal annealing; silicon compounds; wide band gap semiconductors  
 ST high electron mobility transistor; two-step silicon nitride passivation; dry etching; rapid thermal annealing; ohmic contacts; surface preparation; performance enhancement; AlGaN-GaN; Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>  
 IPC C21D0001-00; H01L0021-02; H01L0029-00  
 CHI AlGaN-GaN int, AlGaN int, GaN int, Al int, Ga int, N int, AlGaN ss, Al ss, Ga ss, N ss, GaN bin, Ga bin, N bin; Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> int, Si<sub>3</sub> int, N<sub>4</sub> int, Si int, N int, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> bin, Si<sub>3</sub> bin, N<sub>4</sub> bin, Si bin, N bin  
 ET V; Ga\*N; Ga sy 2; sy 2; N sy 2; GaN; Ga cp; cp; N cp; GaN-GaN; Al\*Ga\*N; Al sy 3; sy 3; Ga sy 3; N sy 3; AlGaN; Al cp; Al; Ga; N; Si; N\*Si; Si<sub>3</sub>N; Si cp; Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>; I\*V; I-VAN 2005:8687118 INSPEC [Full-text](#)

## ALL 形式での表示 (アーカイブレコード)

AN 1968:C07302 INSPEC DN 1968C07302 [Full-text](#)  
 TI Study of the stability and accuracy of an automatic bolometer  
 AU Peffer, J.  
 SO Bulletin Scientifique de l'Association des Ingenieurs Electriciens sortis de l'Institut Electrotechnique, Montefiore (May 1967 - June 1967), vol. 80, no. 3, p. 89-95  
 DT Journal  
 CY Belgium  
 LA French  
 AB A Wheatstone bridge incorporating 2 thermistors is initially balanced at d.c. or l.f.a.c.; following application of h.f. power to one thermistor it is rebalanced, the change corresponding to the h.f. energy. Stability of a self-balancing system is investigated theoretically; an instrument with arrange up to 20 mW gives an accuracy of 2%.  
 CC C3380D Control of physical instruments; C1320 Stability in control theory; C3110E Power and energy control; C3240D Electric transducers and sensing devices; B7230 Sensing devices and transducers  
 CCO 5.9.40 Physical instruments; 2.04.0 Stability; 3.1.30 Power and energy control; 4.2.10 Electric sensing and measuring devices  
 CT physical instrumentation control; power control; electric sensing devices; stability  
 CTO physical instruments; power and energy control; sensing and measuring devices. electric; stability

## IND 形式での表示

AN 2010:11070133 INSPEC  
 CC A8760I Medical magnetic resonance imaging and spectroscopy; A8770E Patient diagnostic methods and instrumentation; A8760M Radiation dosimetry in medical physics; A8750E Bio-optics (effects of microwaves, light, laser and other electromagnetic waves); B7510N Biomedical magnetic resonance imaging and spectroscopy; B6135 Optical, image and video signal processing; B7530B Radiation protection and dosimetry; C7330 Biology and medical computing; C5260B Computer vision and image processing techniques  
 A61B0005/055 Involving electronic [emr] or nuclear [nmr] magnetic resonance, e.g. magnetic resonance imaging  
 G06F0019/00 Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific applications  
 G06T Image data processing or generation, in general  
 CT biological organs; biological tissues; biomedical MRI; dosimetry; electromagnetic waves; feature extraction; image reconstruction; image segmentation; physiological models  
 ST surface-based anatomical models; dosimetric simulations; electromagnetic exposure; optimized evaluation; high resolution magnetic resonance images; tissue; image segmentation; semiautomated tool; organs; image reconstruction; three-dimensional unstructured triangulated surface objects; high precision images; body features; meshing flexibility; traditional voxel-based representation; anatomical models; conformal computational techniques; virtual family; age 34 yr; age 26 yr; age 11 yr; age 6 yr  
 IPC A61B0005-055; G06F0019-00; G06T  
 PHP age 3.4E+01 yr; age 2.6E+01 yr; age 1.1E+01 yr; age 6.0E+00 yr  
 ET D